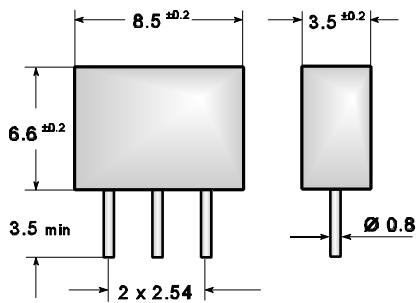
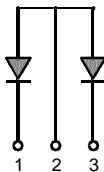


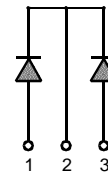
**Rectifier Arrays**
**Gleichrichter Sätze**


Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	1.2 W
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	150 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	8.5 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0,6 g

Dimensions / Maße in mm

 Standard packaging: bulk  
 Standard Lieferform: lose im Karton


"DAP": com. anodes / gemeinsame Anode



"DAN": com. kathodes / gemeinsame Kathode

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Typ	Periodische Spitzensperrspg.	Stoßspitzensperrspannung
	$V_R$ [V]	$V_{RM}$ [V]
DAN 208	100	150
DAP 208	100	150

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	1 A <sup>1)</sup>
Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, superimposed on rated load, one diode only Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast, für eine Diode	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	10 A
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	– 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	– 50...+150°C

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics	Kennwerte			
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	$V_F$	$< 1.2\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 100\text{ V}$	$I_R$	$< 10\ \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	$< 45\text{ K/W}^1)$

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden